2Ap01

## 第一原理計算による電荷移動錯体の電子状態解析

ソニー(株)融合領域研究所 〇国清敏幸、鵜川彰人

【序】(TTF)(TCNQ)に代表される一次元電子系を持った電荷移動錯体では、その一次元 金属性に由来する不安定性により、パイエルス転移という金属一絶縁体相転移を引き起こす事が 知られている。一方で、同じような一次元的電子構造を持ちながら、LHe温度以下まで安定な 金属状態を保つ(TSeT)(BTDA-TCNQ)錯体において、パイエルス転移を引き起こさ ないという報告がなされている[1]。そこで、本研究では、その現象を理論的に解明すべく、(T SeT)(BTDA-TCNQ)の第一原理計算による電子状態解析を行った。

【方法】バンド計算には、ウィーン大学のウルトラソフト擬ポテンシャル法による第一原理電子 状態計算プログラムVASP(Vienna Ab-initio Simulation P ackage)を用い [2-5]、一般化勾配近似(GGA)による密度汎関数法(DFT)によるバ ンド解析を行った。カットオフエネルギーは、350eVとし、結晶の格子定数及び、内部の原 子座標は実験により得られたものを用いて、セルフコンシステント計算を行った。計算には、6 ×6×6k点メッシュを用いている。



図1 (TSeT)(BTDA-TCNQ)結晶構造 (左: *c*軸方向、右: *a*軸方向から 見た図)

【結果】計算により得られたバンド構造を図2に示す。フェルミエネルギーを0 e Vで基準にと り、 $\Gamma$ =(0,0,0)、X=(a\*/2,0,0)、Y=(0,b\*/2,0)、Z=(0,0, c\*/2)として、基本逆格子ベクトル方向のバンド分散を表している。この結果から、結晶構造 から予想されるように、分子の積み重なり方向である c軸に沿って1次元的なバンド構造を形成 していることが確認された。TS e TのHOMOバンド幅は約1 e V、BTDA-TCNQのL UMOバンド幅は約0.4 e Vと見積られ、これらのバンドが形成されていないことから、 完全な1次元バンド構造であると仮定すると、c\*方向のフェルミ波数を  $k_F$  と置くとき、ドナー、 アクセプタ間の電荷移動量  $\rho$  について、次の関係が成立する。

$$\rho = 4k_{\rm F}/c^*$$

この関係から予想される電荷移動量は $\rho \sim 0.8$ であり、結合長から見積った値 $\rho \sim 0.9 \pm 0.$ 1の測定誤差範囲内に収まっている。偏向反射スペクトルをDrudeモデルで解析して、TS eTとBTDA-TCNQの2種類の伝導パスから成るバンドの換算有効質量とバンド幅はそれ ぞれ0.71m。、1.12eVとなることが報告されているが、計算から得られた値1.1m。、 1. 4 e Vは、これによく一致している。これらのことから、現実の電子状態を反映した計算結 果が得られていることが確認できた。

この計算により得られた状態密度分布を図3に示す。同じくフェルミレベルを0 e Vで基準に している。このフェルミレベル付近を詳細に解析すると、フェルミレベル直近の状態密度はほと んど存在しない、すなわち、バンド交差により、僅かなギャップが生じていることが明らかにな った。この計算で得られたモデルは、(TSeT)(BTDA-TCNQ)の電気伝導度が30K 付近でほぼ一定の値となり、典型的な金属とは異なった温度依存性を示すこと、また、このこと は、一次元的な電子構造でありながら(TTF)(TCNQ)などの一次元金属電子系に見られる パイエルス転移を起こさない、という実験事実を見事に説明するものである。



状態密度分布 図 3

- [1] A. Ugawa, K. Iwasaki, A. Kawamoto, and K. Yakushi, Phys. Rev. B 43, 14718 (1991)
- [2] G. Kresse and J. Hafner, Phys. Rev. B 47, 558 (1993)
- [3] G. Kresse and J. Furthmuller, Comput. Mat. Sci. 6, 15 (1996)
- [4] G. Kresse and J. Furthmuller, Phys. Rev. B 54, 11 169 (1996)
- [5] G. Kresse and J. Hafner, J. Phys.: Condens. Matt. 6, 8245 (1994)